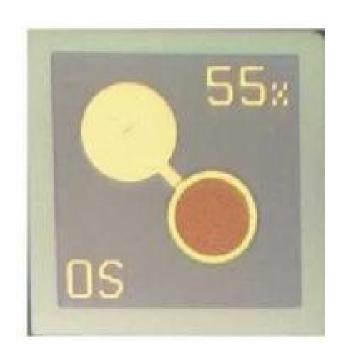


1.25-2.5 Gbps InGaAs PIN PD Chip φ55um



产品描述

InGaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

数据速率高达 2.5Gbps; φ55um 有效面积; 高响应度; 顶照式平面结构

应用领域

EPON ONU | 2.5Gbps 接收器 | 光纤数据通信











详细参数

规格(Tc=25°C,单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
响应度	R	0.8	0.95		A/W	λ=1310-1550nm
暗电流	I _D		0.05	0.3	nA	V _R =-5V
电容	С		0.30	0.5	pF	V _R =-2V,f=1MHz
带宽	Bw		3.0		GHz	V _R =-2V
טע יח	DW		3.0		OHZ	3dB down,RL=50Ω
有效区直径	D		55		um	
芯片尺寸			220*220*120		um	L*W*H